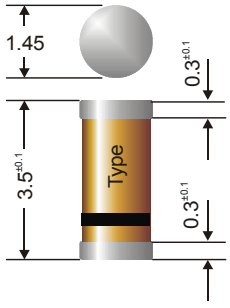
Surface Mount Si-Schottky Barrier Diodes | **Silizium-Schottky-Dioden für die Oberflächenmontage**



Dimensions / Maße in mm

Nominal current Nennstrom	15 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	40…60 V
Glass case MiniMELF Glasgehäuse MiniMELF	SOD 80 DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.05 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings and Characteristics | **Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] / I_F = 1 mA	V_F [V] / I_F = 15 mA
LL 101C	40	< 0.39	< 0.9
LL 101B	50	< 0.4	< 0.95
LL 101A	60	< 0.41	< 1

Power dissipation – Verlustleistung		T_A = 25 °C	P_{tot}	400 mW[1])
Peak forward surge current, 10 µs squarewave Stoßstrom für einen 10 µs Rechteckimpuls		T_A = 25°C	I_{FSM}	2 A
Leakage current, T_j = 25°C Sperrstrom	LL101C LL101B LL101A	V_R = 30 V V_R = 40 V V_R = 50 V	I_R I_R I_R	< 200 nA < 200 nA < 200 nA
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	V_R = 0 V	f = 1 MHz	C_{tot}	< 2.2 pF
Reverse recovery time Sperrverzug	I_F = 5 mA through/über I_R = 5 A to/auf I_R = 0.5 mA		t_{rr}	typ. 1 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur			T_j	+200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur			T_S	- 55...+200°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 300 K/W [1])

[1]) Valid provided that terminals are kept at ambient temperature
Gültig wenn Anschlüsse auf Umgebungstemperatur gehalten werden